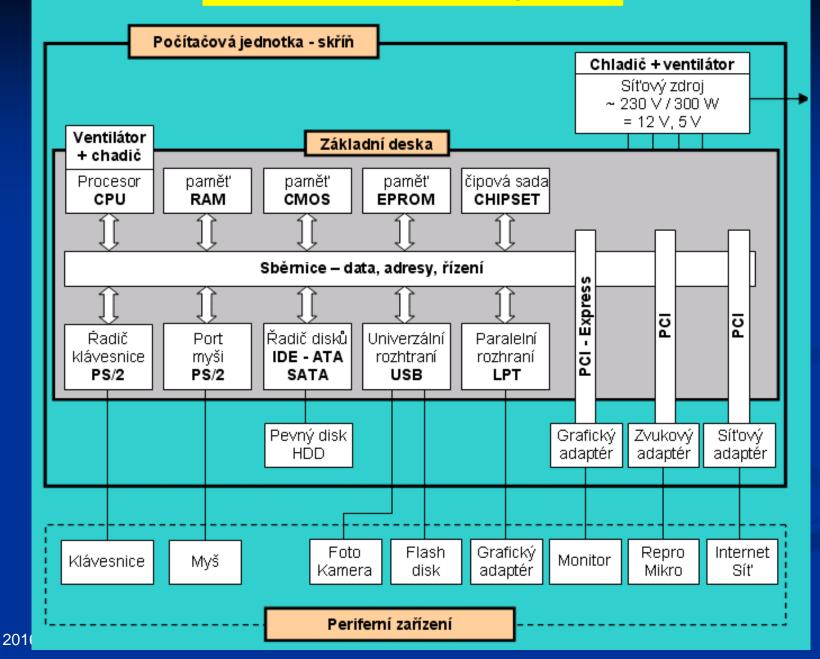
Začlenění a rozdělení typů pamětí

Blokové schéma osobního počítače



2

Základní parametry pamětí jsou:

- kapacita: množství informací, které je možné do paměti uložit
- přístupová doba: doba, kterou je nutné čekat od zadání požadavku, než paměť zpřístupní požadovanou informaci
- přenosová rychlost: množství dat, které lze z paměti přečíst (do ní zapsat) za jednotku času
- statičnost / dynamičnost
 - statické paměti: uchovávají informaci po celou dobu, kdy je paměť připojena ke zdroji elektrického napětí
 - **dynamické paměti**: zapsanou informaci mají tendenci ztrácet i v době, kdy jsou připojeny k napájení. Informace v takových pamětech je nutné tedy neustále periodicky oživovat, aby nedošlo k jejich ztrátě.

destruktivnost při čtení:

- **destruktivní při čtení**: přečtení informace z paměti vede ke ztrátě této informace. Přečtená informace musí být následně po přečtení opět do paměti zapsána.
- nedestruktivní při čtení: přečtení informace žádným negativním způsobem tuto informaci neovlivní.

energetická závislost:

- energeticky závislé: paměti, které uložené informace po odpojení od zdroje napájení ztrácejí
- energeticky nezávislé: paměti, které uchovávají informace i po dobu, kdy nejsou připojeny ke zdroji elektrického napájení.
- přístup sekvenční: před zpřístupněním informace z paměti je nutné přečíst všechny předcházející informace
- přímý: je možné zpřístupnit přímo požadovanou informaci
- **spolehlivost:** střední doba mezi dvěma poruchami paměti
- cena za bit: cena, kterou je nutno zaplatit za jeden bit paměti

2016-04-11 3

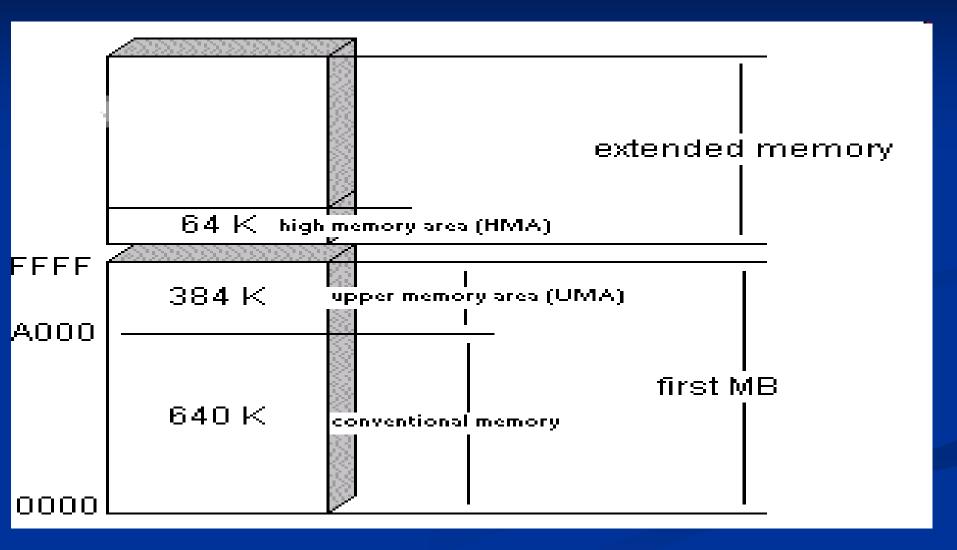


Úvodem jejich začlenění

Paměťová hierarchie reálného počítače Procesor Řídící jednotka Vedlejší paměť Hlavní Off-chip (disk) paměť level 2 On-chip Registry (DRAM) caches Datová (SRAM) caches část Nejpomalejší Rychlost: Nejrychlejší Velikost: Nejmenší Největší Cena/capacita: Největší Nejmenší Úroveň: Nejvyšší Nejnižší Vzdálenost: Nejmenší Největší

- RAM Random Access Memory
- Paměti určené pro zápis i pro čtení dat
- Jedná se o paměti, které jsou energeticky závislé
- Jsou dále rozdělovány na:
 - DRAM Dynamické RAM
 - SRAM Statické RAM

Souvislost s logickou organizací OP



2016-04-11 7

Logická organizace OP

| REZE RVO | 1024-1 K | BIOS pro systém. desku | FFFFF F0000 |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|
| VAN Á O. | 960 K | Rezervovaná oblast | EFFFF |
| | | | C0000 |
| VIDE O | 768 K | Textová oblast VGA | BFFFF B8000 |
| RAM | 736 K | Monochromat. text. část | B7FFF B0000 |
| | 704 K | Grafická oblast EGA/VGA/SVGA | AFFFF |
| | | EGA/VGA/SVGA | A0000 |
| KON VENČ NÍ PAMĚ Ť | 640 K | Uživatelské programy | 9FFFF |
| | | | |
| | | Rezidentní programy | 00000 |
| | | CAMMAND.COM | 00000 |
| | | Ovladače zařízení | |
| | | DOS | |
| | 0 K | Vektory přerušení | |

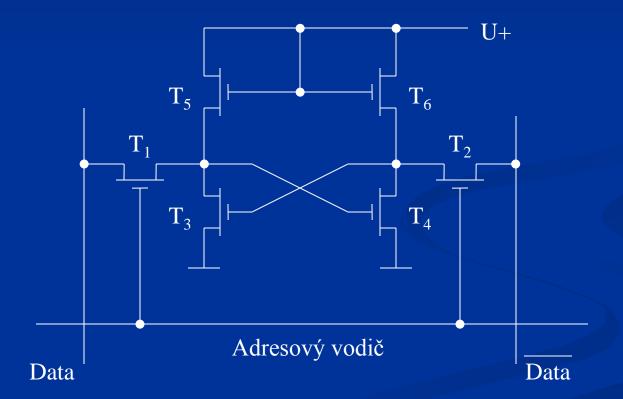
Obr. 3.5: Paměťová mapa do 1 MB 2016-04-11

- SRAM Static Random Access Memory
- Uchovávají informaci v sobě uloženou po celou dobu, kdy jsou připojeny ke zdroji elektrického napájení
- Paměťová buňka je realizována jako bistabilní klopný obvod, tj. obvod, který se může nacházet vždy v jednom ze dvou stavů, které určují, zda v paměti je uložena 1 nebo 0
- Mají nízkou přístupovou dobu (1 20 ns)

- Jejich nevýhodou je naopak vyšší složitost a z toho plynoucí vyšší výrobní náklady
- Jsou používány především pro realizaci pamětí typu cache (L1, L2 i L3)
- Paměťová buňka používá dvou datových vodičů:
 - Data: určený k zápisu do paměti
 - Data: určený ke čtení z paměti
 Hodnota na tomto vodiči je vždy opačná než hodnota uložená v paměti

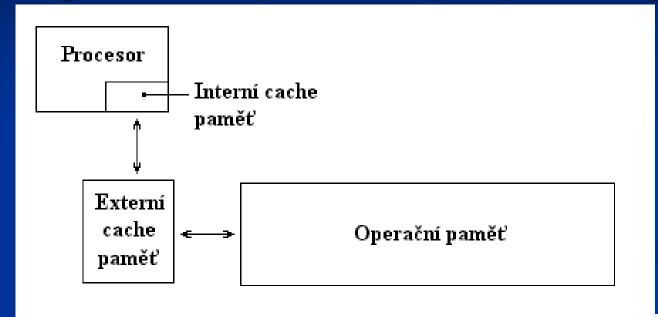
Paměti SRAM (3)

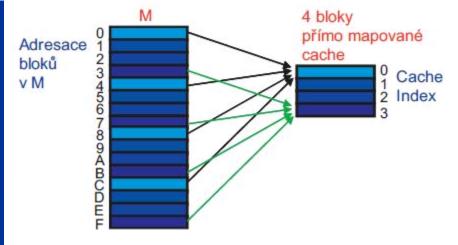
Paměť ová buňka SRAM:



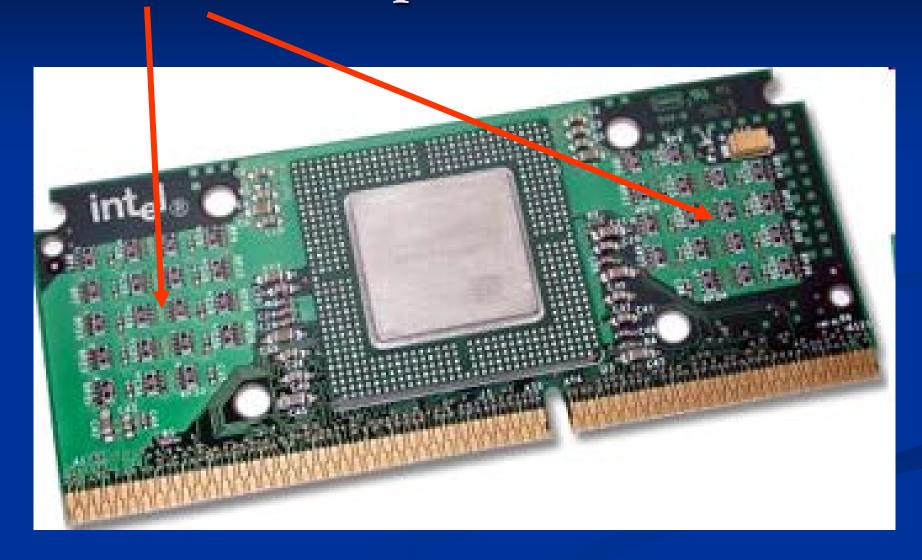
Paměť cache

obecně je to mezisklad mezi různě rychlými částmi počítače, který celkově urychluje tok dat při zpracování



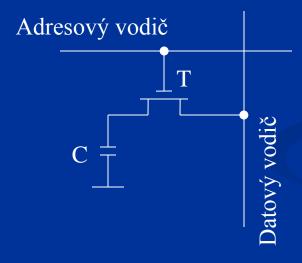


Cache L2 na procesorové desce

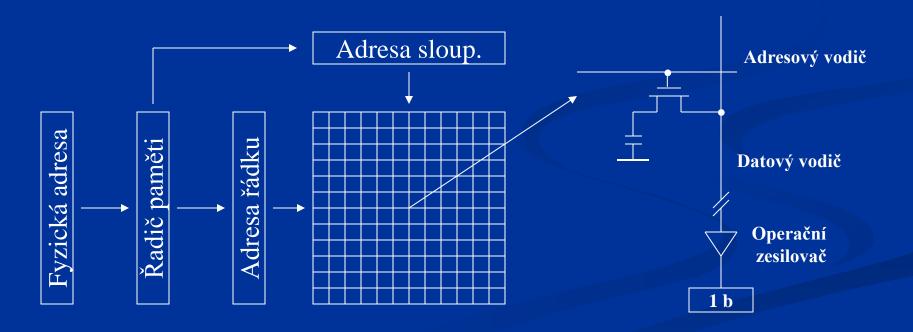


- DRAM <u>Dynamic Random Access Memory</u>
- Informace je uložena pomocí elektrického náboje na kondenzátoru
- Tento náboj má však tendenci se vybíjet i v době, kdy je paměť připojena ke zdroji elektrického napájení
- Aby nedošlo k tomuto vybití a tím i ke ztrátě uložené informace, je nutné periodicky provádět tzv. refersh, tj. oživování paměťové buňky

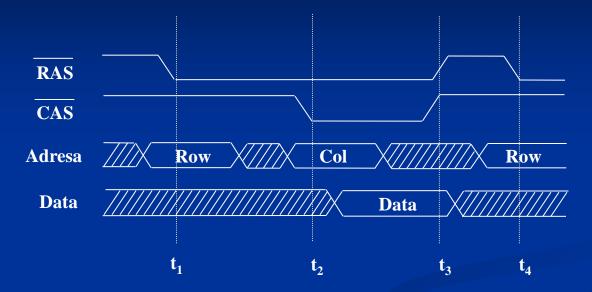
- Její nevýhodou je však vyšší přístupová doba (10 70 ns) způsobená nutností provádět refresh a časem potřebným k nabití a vybití kondenzátoru
- Buňka paměti DRAM:



Obvody operačních pamětí pak bývají realizovány jako matice, např. 1024 × 1024 buněk (kapacita 1 Mb).



- Protože paměťové obvody nemohou mít příliš velký počet vývodů, je nutné, aby adresa řádku i sloupce byla předávána po stejné sběrnici
- Platnost adresy řádku a sloupce na sběrnici je dána (potvrzována) signály:
 - RAS (Row Access Strobe): adresa řádku
 - CAS (Coloumn Access Strobe): adresa sloupce



Vždy nutno nastavit adresu řádku i adresu sloupce

Použité zdroje:

- HORÁK, Jaroslav. Hardware učebnice pro pokročilé. Brno: CPRESS, 2007, ISBN 978-80-251-1741-5.
- DEMBOWSKI, Klaus. *Mistrovství v HARDWARU*. Brno: CPRESS, 2009, ISBN 978-80-251-2310-2.
- PETŘÍČEK, Lukáš. *Vývoj modulů DRAM a operační paměti* [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.svethardware.cz/art_doc-A6F55FA383F23A0EC1257206006DD3D3.html
- KWOLEK, Jirka. Nastavení paměti a dopad na výkon celého systému [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://pctuning.tyden.cz/component/content/4829?task=view&limit=1&start=2
- EAGLE. Technologie: Fully Buffered FB-DIMM [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.svethardware.cz/art_doc-78014566F350DC89C1256E9000482DDB.html
- MUMI.CZ. *Vnitřní paměti* [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/INTPAM.HTML
- CARDA, Jakub. *Test tří nadupaných motherboardů s Intel P67 pro Sandy Bridge* [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/INTPAM.HTML